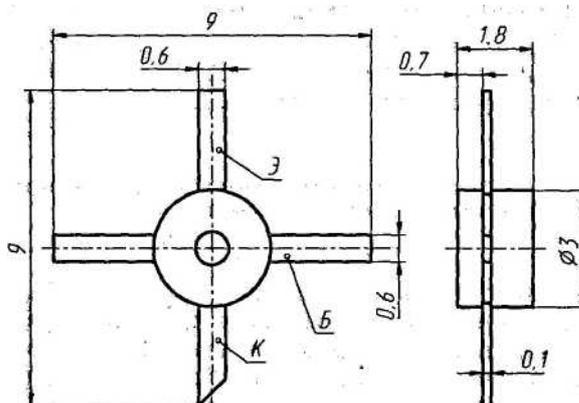


A633

Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный структуры *p-p-n* генераторный. Предназначен для применения в генераторах и усилителях в диапазоне частот 1...10 ГГц в схеме с общей базой при напряжении питания 15 В. Бескорпусной на кристаллодержателе с гибкими выводами. На крышку транзистора наносится полоска зеленого цвета. Тип прибора указывается в этикетке.

Масса транзистора не более 0,2 г.

Изготовитель — завод «Пульсар», г. Москва.



Электрические параметры

Выходная мощность на $f = 10$ ГГц при $U_{КБ} = 15$ В, $I_K = 60$ мА, $P_{вх} = 100$ мВт (медианное значение), не менее	200 мВт
Коэффициент усиления по мощности на $f = 10$ ГГц при $U_{КБ} = 15$ В, $I_K = 60$ мА, $P_{вк} = 100$ мВт (медианное значение), не менее	3 дБ
Фаза коэффициента передачи тока в схеме ОБ на высокой частоте при $U_{НБР} = 5$ В, $I_K = 35$ мА, на $f = 1$ ГГц, не более	16°
Модуль коэффициента обратной передачи напряжения в схеме ОБ на высокой частоте при $U_{КБ} = 7$ В, $I_K = 35$ мА, $f = 100$ МГц, не более ..	$1,6 \times 10^{-3}$
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 15$ В, не более	1,5 пФ
Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = 18$ В, не более	1 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ} = 2$ В, не более	0,2 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база	18 В
Постоянное напряжение эмиттер—база	2 В
Потенциал статического электричества	100 В
Постоянный ток коллектора	90 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора ¹ при $T_K = -60...+80$ °С	0,56 Вт
Средняя рассеиваемая мощность коллектора ² при $T_K = -60...+50$ °С	0,8 Вт
Температура <i>p-n</i> перехода	+150 °С
Тепловое сопротивление переход—корпус	125 °С/Вт
Температура окружающей среды	— 60... $T_K = +125$ °С

¹ При $T_K > +80$ °С максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора рассчитывается по формуле

$$P_{K_{\text{МАКС}}} = (150 - T_K) / 125 \text{ Вт}$$

² При $T_K > +50$ °С максимально допустимая средняя рассеиваемая мощность коллектора в динамическом режиме рассчитывается по формуле

$$P_{K_{\text{СР.МАКС}}} = (150 - T_K) / 125 \text{ Вт}$$

Режим считается статическим при $P_{\text{вых}} = 100$ мВт.

При монтаже транзисторов в гибридной схеме рекомендуется производить приклеивание основания кристаллодержателя транзисторов к теплоотводящей поверхности монтажной платы теплопроводящим клеем УП-5-207М ТУ 6-05-241-208-79. Перед нанесением клея кристаллодержатель транзистора и монтажная плата должны быть прогреты при +60 °С в течение 6 мин. Клей должен быть нанесен тонким равномерным слоем, соединение склеиваемых поверхностей производить прижатием так, чтобы избыток клея равномерно выступал из-под основания. Не допускается наличие щелей и свищей. После приклеивания производится подсушка при +120 °С в течение 1 ч и при +150 °С в течение 2 ч. Разрешается производить монтаж транзистора припайкой металлизированного основания кристаллодержателя к теплоотводящей поверхности при температуре пайки не выше +180 °С.

Изгиб выводов допускается на расстоянии не менее 1 мм от кристаллодержателя с радиусом закругления 0,5 мм. Пайка выводов производится на расстоянии 2 мм от кристаллодержателя, температура пайки не выше +260 °С, время пайки не более 3 с. Допускается пайка выводов на расстоянии 0,5 мм при температуре пайки не выше +150 °С, время пайки не более 3 с. Допускается обрезка выводов на расстоянии не менее 1 мм от кристаллодержателя.

Допускается использование транзисторов в диапазоне частот от 10 МГц до 1 ГГц в усилителях и генераторах мощности при напряжении питания не более 8 В.

Защитное покрытие транзистора — лак КО—08 по ГОСТ 15081.